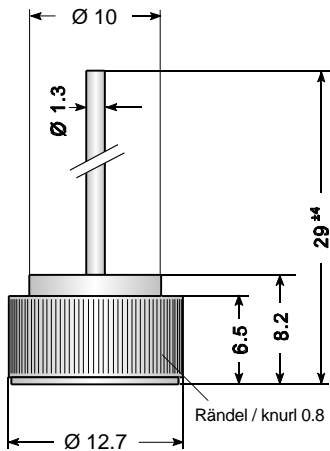


Silicon Press-Fit-Diodes
Silizium-Einpreßdioden


Dimensions / Maße in mm

 Nominal current – Nennstrom 25 A

 Repetitive peak reverse voltage 50...400 V
 Periodische Spitzensperrspannung

 Metal press-fit case with plastic cover
 Metall-Einpreßgehäuse mit Plastik-Abdeckung

 Weight approx. – Gewicht ca. 10 g

 Casting compound has UL classification 94V-0
 Vergußmasse UL94V-0 klassifiziert

 Standard packaging: bulk
 Standard Lieferform: lose im Karton

Maximum ratings
Grenzwerte

Type / Typ		Rep. peak reverse voltage	Surge peak reverse voltage
Wire is / Draht ist		Period. Spitzensperrspannung	Stoßspitzensperrspannung
Kathode	Anode	V_{RRM} [V]	V_{RSM} [V]
KYP 70	KYP 75	50	60
KYP 71	KYP 76	100	120
KYP 72	KYP 77	200	240
KYP 73	KYP 78	300	360
KYP 74	KYP 79	400	480

 Max. average forward rectified current, R-load $T_C = 100^\circ\text{C}$ I_{FAV} 25 A
 Dauergrenzstrom in Einwegschtung mit R-Last

 Repetitive peak forward current $f > 15\text{ Hz}$ I_{FRM} 80 A ¹⁾
 Periodischer Spitzenstrom

 Rating for fusing, $t < 10\text{ ms}$ $T_A = 25^\circ\text{C}$ i^2t 375 A²s
 Grenzlastintegral, $t < 10\text{ ms}$

 Peak fwd. surge current, 60 Hz half sine-wave $T_A = 25^\circ\text{C}$ I_{FSM} 300 A
 Stoßstrom für eine 60 Hz Sinus-Halbwellen

¹⁾ Valid, if the temperature of the case is kept to 100°C – Gültig, wenn die Gehäusetemperatur auf 100°C gehalten wird

Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur T_j – 50...+175 °C
 Storage temperature – Lagerungstemperatur T_s – 50...+175 °C

Maximum pressure – Maximaler Einpreßdruck 7 kN

Characteristics **Kennwerte**

Forward voltage $T_j = 25^\circ\text{C}$ $I_F = 25\text{ A}$ V_F < 1.1 V
 Durchlaßspannung

Leakage current $T_j = 25^\circ\text{C}$ $V_R = V_{RRM}$ I_R < 100 μA
 Sperrstrom

Thermal resistance junction to case R_{thC} < 1 K/W
 Wärmewiderstand Sperrschicht – Gehäuse

